# Облікова картка ДіР

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0307U001919

**Державний реєстраційний номер:** 0106U001656

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 13-06-2007

## II. Етап виконання ДіР

**Номер етапу:** 1

**Назва етапу:** Розробка технології виготовлення активних елементів на основі GaAs, проведення попередніх випробувань

**Початок етапу:** 01.2006

**Закінчення етапу:** 12.2006

**Вид звітного документа:** Без звіту

## III. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Інститут технічної механіки НАН України і НКА України

**Код за ЄДРПОУ:** 05539962

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 45-12-38

## IV. Відомості про співвиконавців ДіР

## V. Відомості про замовника ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Національна академія наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 00019270

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 380442396594

## VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

**Підстава для проведення ДіР:** 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

**Напрям фінансування:**

### Джерела фінансування

## VII. Відомості про ДіР

### Назва роботи українською:

Розробка багатофункціональних елементів і вузлів для систем керування та зв'язку на основі арсеніду галію

### Назва роботи англійською:

Development of GaAs - based multifunctional control and communication elements and units

### Реферат українською:

Об єкт дослідження -активні елементи на основі GaAs. Метод дослідження - інформаційно-аналітичний та експериментальний. Розроблено проект технічного завдання на технологію виготовлення активних елементів на основі GaAs та технологічний процес обробки напівпровідникового матеріалу GaAs і формування омічних контактів до нього. Область застосування - виробництво напівпровідникових - пристроїв.

### Реферат англійською:

The study is concerned with GaAs-based active elements.The investigation method is informational-analytical and experimental. A tentative requirements specification for GaAs-based active element technology has been drawn up, and a GaAs semiconductor material handling and ohmic contact formation process has been developed. The field of application is semiconductor device manufacturing

**Індекс УДК:** 621.37/.39.002.2; 621.37/.39.002.5, 621. 382

**Коди тематичних рубрик:** 47.13

**Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Привалов Євген Миколайович

**Науковий ступінь:**

**Вчене звання:**

**Ідентифікатор ORCID ID:**

**Додаткова інформація:**

## VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

## IX. Бібліографічний опис

54905490

## X. Заключні відомості

**Керівник юридичної особи** Пилипенко Олег Вікторович
д. т. н., 05.07.05

**Перелік осіб-виконавців**

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Телефон**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності**

